

Verwendung: Germanium-pnp-Transistor für Verstärker, Misch- und Oszillatorstufen im Nieder- und Mittelfrequenzgebiet bei Umgebungstemperaturen ϑ_a bis $+65^\circ\text{C}$

GC 100

Standard: TGL 200-8391

Abmessungen: Bauform A 3/25-b,
TGL 11 811
Masse $\approx 0,8$ g

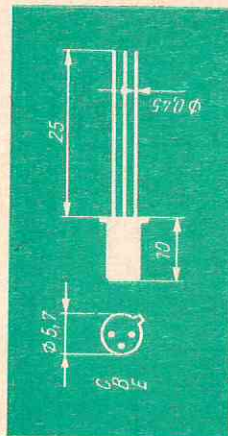
Zulässige Höchstwerte

für $\vartheta_a = 45^\circ\text{C}$

-UCBO = 15 V	-IB = 5 mA
-UEBO = 10 V	P _{tot} = 30 mW
-IC = 15 mA	$\vartheta_j = 75^\circ\text{C}$
I _E = 15 mA	$\vartheta_a = 65^\circ\text{C}$

Wärmewiderstand $R_{th} \leq 1 \frac{\text{grad}}{\text{mW}}$

Kennwerte für $\vartheta_a = 25^\circ\text{C} - 5^\circ\text{C}$



		Meßbedingungen	
	Min	Typ	Max
Restströme			
-ICBO		1,5 μA	15 μA
-ICBO		80 μA	500 μA
-ICEO		40 μA	600 μA
-IEBO		40 μA	500 μA
Grenzfrequenz			
f _{h21b}	1 MHz	2,1 MHz	-UCB = 6 V, -IC = 1 mA, f = 3 MHz
Rauschmaß			
F		14 dB	25 dB
-UCE = 1 V, -IC = 0,2 mA, f = 1 kHz $\Delta f = 1 \text{ kHz}, R_g = 500 \Omega$			